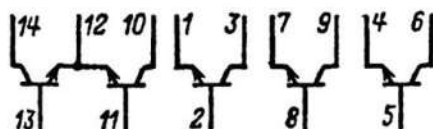


# К198НТ1А, К198НТ1Б, КР198НТ1А, КР198НТ1

Микросхемы представляют собой матрицу п-р-п транзисторов. Содержат 5 интегральных элементов. Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,8 г и типа 201 14-1. масса не более 1 г.



Электрическая схема К198НТ1

Назначение выводов: 1 — эмиттер транзистора VT3; 2 — база транзистора VT3; 3 — коллектор транзистора VT3; 4 — эмиттер VT5; 5 — база VT5; 6 — коллектор VT5; 7 — эмиттер VT4; 8 — база VT4; 9 — коллектор VT4; 10 — коллектор VT2; 11 — база VT2; 12 — эмиттер транзисторов VT1 и VT2; 13 — база VT1; 14 — коллектор VT1.

## Электрические параметры

Напряжение насыщения база — эмиттер	≤ 1 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер	≤ 0,7 В
Напряжение смещения нуля дифференциальной пары	≤ 4 мВ
Обратный ток коллектора	≤ 0,04 мкА
Статический коэффициент передачи тока:	
К198НТ1А, КР198НТ1А	20...125
К198НТ1Б, КР198НТ1Б	60...250
Разброс коэффициента передачи тока дифференциальной пары	≤ 15%

## Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор — база	20 В
Напряжение эмиттер — база	5 В
Ток коллектора	10 мА
Рассеиваемая мощность одним транзистором	20 мВт
Температура окружающей среды	-45...+85 °С